

半 导 体 学 报

第 3 卷 第 1 期 1982 年 1 月

目 录

GaAs-Al _{0.3} Ga _{0.7} As DH 激光器近场光谱的研究	张敬明 郑宝真 (1)
液相外延生长的 Al _x Ga _{1-x} As/GaAs 异质结构的俄歇电子能谱	
.....余金中 鞠静丽 石志文 马国荣 刘福源 王维明 (8)	
双异质结 (DH) 激光器-光纤高效耦合	周汝生 朱柏生 张 伦 (15)
用椭圆偏振光谱法研究溅射无定形硅的光学性质	陈树光 叶贤京 莫 党 (23)
金属-n 型 GaAs 界面物理特性研究	陈克铭 王良臣 王佑祥 (31)
用 MOS 电容瞬态电流-电容法直接测定少数载流子的体产生寿命分布和表面 产生速度	孙勤生 (45)
MOS 结构的软 X 射线辐射损伤	郑有料 吴凤美 (55)
背散射和核反应技术用于氮化硅薄膜分析	
.....承焕生 徐志伟 赵国庆 周筑颖 任月华 王季陶 (62)	
ECL 1024 字×1 位 随机存储器	
.....张 敏 杨华丽 罗杏珍 余北梁 陈明琪 郑应杨 (68)	

研 究 简 报

硅中离子注入层光学常数的振荡分布	钱佑华 陈良尧 张继昌 (76)
------------------------	--------------------

学 术 讨 论

关于“P ⁺ 注入硅损伤层的椭圆偏振术研究”一文的讨论	莫 党 (80)
--	------------

会 议 简 讯

第五届国际气相生长和外延会议和美国第五届晶体生长会议简讯	
.....彭瑞伍 林耀望 (82)	
第四次国际窄禁带半导体物理会议	普 霖 (83)
1982 年半导体国际会议消息	(84)